科学研究費助成事業

研究成果報告書

今和 4 年 5 月 2 6 日現在

機関番号: 14401	
研究種目: 基盤研究(C)(一般)	
研究期間: 2019~2021	
課題番号: 19K05196	
研究課題名(和文)カドミウムフリー量子ドットの表面修飾による高機能化	

研究課題名(英文)Functionalization of cadmium-free quantum dots by surface modifications

研究代表者

上松 太郎 (Uematsu, Taro)

大阪大学・工学研究科・講師

研究者番号:20598619

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,300,000円

研究成果の概要(和文):最近、硫化ガリウムとのコア/シェル化により発光スペクトルの単色化に成功したカ ドミウムフリー量子ドット「硫化銀インジウム」を中心とし、発光機能の一層の向上と、実用的な耐久性付与を 目指し、様々な方法による表面修飾を実施した。無機材料やハイブリッド材料である金属誘起構造体(MOF)を量 子ドット表面から直接成長させるため、合成直後の量子ドットに結合している表面配位子を脱離性の高いものに 交換した後、成長させる材料の原料物質をゆっくりと添加した。電子顕微鏡観察により、これらの材料に包埋さ れた量子ドットが得られたことが確認され、耐久性向上や、光機能の相乗効果による量子ドットの発光強度増加 に成功した。

研究成果の学術的意義や社会的意義 光の波長を変換する物質である蛍光体は、照明やディスプレイなど社会のあらゆる場面で活躍しており、情報社 会の根幹をなす技術である。そして量子ドットは、様々な波長で励起することができ、色純度の高い光を発する 新しいカテゴリーの蛍光体である。カドミウム化合物を中心に開発されたが、社会実装とともにカドミウムフリ ー化が強く求められており、我々は現在有力候補とされる2つのうち1つである「硫化銀インジウム量子ドッ ト」を開発した。本研究は、ナノ材料の表面を分子レベルでデザインすることで、機能強化や耐久性向上を図っ たものである。

研究成果の概要(英文): The cadmium-free quantum dot "silver indium sulfide", which we have successfully obtained the monochromatic emission by gallium sulfide shell coating, were examined for further improve the photoluminescence properties and impart practical durability. Various surface modifications were applied, i.e., growing inorganic materials or hybrid materials directly from the quantum dot surface. The sources of these materials were injected dropwise to the solution of quantum dots, whose capping ligands had been exchanged to easily removable one. An incorporation of the quantum dots were conformed by a transmission electron microscopy, and an improvmenet of durability and/or an enhancement of the quantum dots were demonstrated by a synergetic effect of the two materials.

研究分野:ナノ材料、光化学、電気化学

キーワード: 量子ドット蛍光体 カドミウムフリー 表面修飾 ゾルーゲル法 金属誘起構造体(MOF) 複合化

科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。

1.研究開始当初の背景

表面を化学修飾された直径数 nm の半導体微粒子であるコロイド状半導体量子ドットは、高 い量子収率と狭いスペクトル半値幅(優れた色純度)を特徴とする発光体である。また、半導体 特有のエネルギーバンド構造が多波長励起を可能とし、青色 LED からディスプレイの発光色を 得る波長変換材料として広く利用されるようになった。量子ドットの開発当初はそのほとんど がセレン化カドミウム (CdSe) をはじめとするカドミウム化合物であったが、民生用途の拡大 とともにカドミウムフリー化が叫ばれるようになり、代替材料の探索が活発化した。ごく最近 (2018 年当時)まで、カドミウムフリー量子ドットの有力候補と呼べるのは元素周期表の 13 族、15 族からなる化合物半導体リン化インジウム (InP) のみであった。それでもスペクトル半 値幅はほとんどのケースで 40~50 nm もあり、可視光域全体にわたって半値幅 30 nm 前後であ る CdSe や硫化カドミウム (CdS) 量子ドットに比べると、特性面で劣っていた。

第 11, 13, 16 族元素によって構成される 3 元系化合物である AgInS₂ も、代替量子ドットの一つとして開発された (J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 12388)。ZnS コーティング等の付加的手

段によって 50%を超える発光量子収率を実現したものの、200 nm (350 meV) を超えるスペクトル半値幅が、先述の高い色純度を求める用途と合致せず、この材料への 関心は低下しつつあった。幅広なスペクトルの原因は、バンドギャップ内に存在する欠陥準位であり、これらを除去すするための研究というのは既に世界中で行われていたが、全く成果が得られなかった。我々は独自の視点からこのナノ粒子の改善に取り組み、量子ドットの研究で使われたことのない硫化ガリウム(GaSx)という材料で表面をコーティングし、「コア/シェル構造」として知られる2 重構造を得たところ、スペクトル半値幅の狭い新たな発光が生じた。詳細な調査を経て、それがバンド間遷移に由来する発光(バンド端発光)であることが判明し、 AgInS2 量子ドットおよび類縁材料として世界初の成果と

して論文発表を行った(図1、T. Uematsu et al., NPG Asia Materials 2018, 10, 713)。同時に明らかになったの は、AgInS2の発光スペクトルが幅広であった理由が表面 にあり、多くの人が考えていた結晶内部の欠陥は、副次的 な要素に過ぎなかったという点である。結果的に、AgInS2 コア/シェル量子ドットの発光スペクトルは半値幅 30 nmにまで狭小化し、さらに有機リン化合物による化学修 飾によって 70%を超える発光量子収率を実現するなど、 カドミウム系量子ドットに迫る特性を実現した。しかし、 GaSxシェルはアモルファス構造を示しており、明確な結 晶性を示しし、CdSe 量子ドットのシェルとして一般的な 硫化亜鉛 (ZnS)に比べれば、化学的耐性はやや劣ってい る。



図1.硫化銀インジウム(AgInS2)/硫 化ガリウム(GaSx)コア/シェル構造に よるバンド端発光の発生。(a)表面欠 陥のある AgInS2 コアにGaSx をコーテ ィングすると、(b)もとの表面がコア /シェル界面に変化することで欠陥準 位が消滅し、(c,d)半値幅の狭いバンド 端発光が得られた。

2.研究の目的

半導体コアの表面を別の半導体で被覆して得られるコア/シェル構造は、量子ドット開発の 黎明期から発光効率向上手段として多用されており、その本質はコア内に生成した励起子を強 く閉じ込め、発光性再結合確率を増加させる点にある。したがって AgInS₂/GaS_x コア/シェル 構造のように、欠陥発光からバンド端発光へと発光メカニズムを大幅転換するシェルは珍しい が、シェルの機能の重要性を示す現象と捉えている。さらに、有機リン化合物の添加が量子収率 を向上させたことは、GaS_x コーティング層のキャリア閉じ込め効果が十分でないことを意味し ていた。以上を踏まえれば、量子ドット発光体のシェルの構造を再検討したり、新たなカテゴリ ーの材料を導入したりすることで、量子ドットコアが有する機能の一層の向上が期待される。ま た、従来の無機物質に代わる新たなシェル材料として、温和な条件下での結晶化が可能な金属 -有機構造体(MOF)の利用も視野に入れ、本研究を実施した。

3.研究の方法

上記経験をもとに、我々は量子ドットの表面・界面が担う役割を強く意識し、次のような計画 を立案した。

(1)量子ドットのシェルの化学耐性向上と、使いやすい量子ドット発光材料の開発 AgInS₂/GaS_xコア/シェル量子ドットに十分な耐久性をもたせ、長期間の光照射に耐え、化学的にも安定な波長変換材料に適した材料にするため、粒子を固体マトリクスに包埋することによって、粒子外部からシェルの構造を支持する新たな構造作製を試みた。

(2)従来の無機物質に代わるシェル材料としての MOF

無機材料のシェルは、十分な結晶化度を得るために 200 以上での長時間の加熱を必要とし、 シェルの形成によるコアの変質が無視できないレベルで発生することも多い。それに対し、有 機・無機ハイブリッド材料である MOF は加えた原料がほとんどそのままの形で結晶構造を形 成し、分子変換を必要としないことから、温和な条件で高い結晶化度を得ることが可能であり、 これを保護層として利用することで、コア / シェル量子ドット設計に新たな概念を提供するこ とを試みた。

(3)機能性シェルの利用と、相乗効果による量子ドット性能向上

MOF を量子ドットの保護層として使用するだけでなく、その光機能を積極利用することを目 指し、発光特性を示す MOF から量子ドットへのエネルギー移動によって、量子ドットの発光 増強を試みた。

4.研究成果

(1)硫化物固体マトリクスへの包埋

シェルと同じ材料である硫化ガリウム (GaS_x) は、量子ドットを保護するマトリクスとしても 有効に機能するのではないかと考えた。当初、シェル形成時に使用する試薬量を増やすことで、 その膜厚をマトリクスとみなせる程度まで増加させようと試みたが、結果的に無発光の白色沈 殿が大量に生成する一方、発光性の成分は溶液に留まり、目的とする発光性固体状物質は得られ なかった。この原因として、原料の増加による硫化ガリウムモノマーの増加と、それにともなう 硫化ガリウムナノ粒子の生成が挙げられる。コア/シェル構造を形成する際、シェルとなる物質 が結晶核となってナノ粒子化しないよう試薬濃度や反応速度を低く保つ必要があるが、バンド 端発光に必要な GaS_xシェル被覆を行う条件を維持しながら、膜厚を増加させることができるか という点ついては、未知数である。したがって、コア/シェル化反応とは別の手段によりマトリ ックスを発生させ、その中に量子ドットを含ませる新たな合成戦略を企てた。

我々が注目したのは、溶液反応により金属酸化物や硫化物の固体を得る反応として知られて いる「ゾルゲル法」である。「光触媒」としても知られる酸化チタンや、シリカ、酸化亜鉛な どの粉末を比較的温和な条件で、分子レベルの制御下において得る方法として、1970年ごろか ら利用されてきた。ゾルーゲル反応のほとんどすべてが水溶液中で実施されるものの、一部は比 較的高極性のアルコール溶媒(メタノール、エタノールやプロパノール)中での実施例もあり、 原料となる金属錯体の選択により、幅広い範囲に適用できる反応として知られている。硫化ガリ ウムは水中においてただちに加水分解を受けるため、当初より非水溶液の利用を目指し、文献探 索を続けていた。最終的に 1-プロパノールを溶媒として利用する反応が量子ドットの取り込み に適した反応速度を示すことが明らかになった。

コア / シェル化直後の量子ドット表面には、粒子形状を維持するための表面配位子であるオ レイルアミンまたはテトラデシルアミンが、アミノ基を起点として多数吸着しており、溶媒側は 完全な炭化水素であるため、極性溶媒であるプロパノールには全く溶解しない。この問題を解決

するため、ゾル-ゲル反応に先立って量子ドットの配 位子を高極性な 4-アミノ-1-ブタノールへと交換した。 しかし、この操作によりシェルの一部がダメージを受 けたとみられ、もともと 70% ほどであった発光量子収 率は、約30%へと大幅に低下してしまった。しかし、 バンド端発光自体はしっかりと維持していたので、シ ェルが完全に失われてしまった状況にはなく、このま ま次の段階に進んだ。4-アミノ-1-ブタノールに修飾さ れた量子ドットを1-プロパノールに溶解させ、さらに ガリウム源と硫黄源を加えたところ、ほとんど無発光 になった。しかし、次第に硫化ガリウムとみられる懸 濁が始まるとともに黄色発光が復活し、最終的に 60% 近いレベルにまで回復した(図2)。なお、反応後に沈 殿物を除去した後の 1-プロパノール溶液には全く量 子ドットが含まれていなかったことから、ゾル-ゲル 反応中に量子ドットが取り込まれたか、あるいは量子 ドットを起点としてゾル-ゲル反応が進行し、最終的 には淡橙色で、紫外照射によって黄色発光する均一な 粉体が得られたと考えられる。



図2. AgInS2/GaSx コア / シェル量子ド ットの、硫化ガリウムへの包埋過程

図3に示すように、硫化ガリウム包埋後の量子ドットは強いバンド端発光を維持しており、この方法によって粒子の特性を損なうことなく、固体化できることが明らかになった。耐久性については、溶液状態の量子ドットが数時間で劣化してしまうに対し、青色 LED 光照射や、80 での耐久試験を実施したところ、500時間後もほとんど同じ特性を維持していることが確認された。また一連の結果から、AgInS₂/GaS_x コア / シェル量子ドットの耐久性がカドミウム系量子ドットに及ばない原因が、コアやコア / シェル界面など粒子内部にあるのではなく、最外部に比較的近い部分、とくに周囲環境によるGaS_xシェルへの化学的ダメージにあることが判明した。バンド端発光を維持したまま粒子構造そのものを変更することは、現実的でなく、したがって表

面の改善によって必要な耐久性が確保できる状況は、同量子 ドットを開発した者にとって幸運な状況であった。

(2) MOF による修飾

MOF による量子ドットの表面修飾は本研究開始以前に も2~3の先行例があったが、そのいずれも無機材料であ る量子ドットと、ハイブリッド材料である MOF との間に、 鎖長の長い炭化水素基やポリマーをリンカー層として挿 入することで、結晶構造や形状の違いによって生じる応力 の緩和を図っていた。しかし、最低でも数 nm の厚さを有 するリンカーを介した接続は、両材料間での電子移動やエ ネルギー移動を困難にし、複合化によるメリットを損なう 可能性を含んでいた。MOF は、金属イオンやクラスター 同士の接続に多座配位子を使用しており、様々な分子によ る結晶材料が報告されているが、多くの場合、金属との結 合部位にはカルボキシル基かアミノ基、あるいはイミダゾ ール基やピリジル基などの含窒素芳香族化合物が使用さ れている。しかし、この点において量子ドット配位子の粒 子表面への結合様式も同様であるため、量子ドットと MOI



図3.(青線)テトラデシルアミ ン修飾および(緑線)4-アミノ-1-プタノール修飾 AgInS₂/GaS_x コア/シェル量子ドットの発光 スペクトル、(赤線)硫化ガリウ ムマトリクス包埋後の固体の発

子表面への結合様式も同様であるため、量子ドットと MOF を直接接合することも可能では ないかと考えた(図4)。



このような試みは初めてであったため、まず量子ドットとして安定した光特性を有する CdSe 量子ドットを利用し、MOF としては常温で安定した結晶が得られる ZIF-8 を利用して実験を開 始した。ZIF-8 の細孔径はおよそ 1 nm であり、量子ドットのサイズ(8 nm)を考えた場合、 MOF を合成した後で量子ドットをその中に取り込むことは不可能と考えられる。また、ボトル シップを組み立てるように MOF 内で量子ドットを成長させるアプローチも存在するが、先に生 成した MOF を維持する必要が生じるため、量子ドット合成反応の条件に強い制約が生じ、コア /シェル量子ドットのような、原子レベルでの分子コントロールを必要とする反応には不向き であると考えた。

そこで、量子ドットの配位子をあらかじめ結合力が弱く、脱離しやすいもの(ピリジン)に交換しておき、その溶液に ZIF-8 の原料となる 2 種類の試薬を添加した。シリンジポンプを用いてゆっくりと滴下することにより、ZIF-8 が単体で結晶核発生してしまうのを防止しながら、量子ドットを種結晶としてその上に析出させた。図5 に示す反応が実際に起こっていることは、TEM 像から明らかであった。ZIF-8 の原料滴下量の増加とともに、菱形 12 面体の ZIF-8 結晶が大きくなっていき、量子ドットがコントラストの強い点としてそのほぼ中心に含まれていた。量子ドットの濃度を低く維持したところ、「ZIF-8 結晶 1 つに含まれる量子ドットが 1 つだけ」という状態も得ることができた。このような状態は、単一光子光源として利用可能であると考え





1構造体に複数の量子ドット ◆ 優れたコントロール性 → 1構造体に1個の量子ドット

図5.CdSe 量子ドット表面から ZIF-8 結晶を成長させ、異種材料のコア/ シェル構造を作製した。ZIF-8 の原料 を滴下し、急激な濃度上昇を抑えるこ とで、ZIF-8 が単体で核発生するのを 防止することが、同コア/シェル構造 実現の鍵であった。 られ、量子通信や暗号化技術に向けた物理学・光学技術への展開が期待される(CrystEngComm 2019, 21, 5568)。

ZIF-8 に取り込まれたカドミウム量子ドットは、十分な発光強度と化学耐久性を示したが、そ もそもカドミウム系量子ドットの性能が高いため、MOF との複合化による効果は限定的であっ た。そこで、次の目標として AgInS₂/GaS_x コア / シェル量子ドットへと展開し、化学的に弱い GaS_x シェルを MOF の結晶によって外側から支えることにより、(1)で紹介した無機材料シェ ルとは別のアプローチによる耐久性向上を試みた。図6 に示すのは、黄色のバンド端発光を示す AgInS₂/GaS_x コア / シェル量子ドットを、インジウムイオンとフマル酸イオンによって構成さ れる InMOF に包埋した例である。黄色の発光を維持したまま固体化することに成功し、耐久性 も大幅に向上した。実は、これに先立ちマトリクスとして ZIF-8 を用いて同様の実験を行った ところ、包埋後1日を経てバンド端発光が完全に消失した。これ以前の研究でも、硫化ガリウム と亜鉛イオンの接触によるコア / シェル界面欠陥の再生は確認されており、固体中であっても 少し時間をかければ同じ問題が生じてしまうことが明らかになった。つまり、マトリクスの選定 が重要であることが示された (*CrystEngComm* 2022, 24, 3715)。

(3)機能性 MOF シェルによる量子ドット発光増強

MOF を単に保護剤として用いるので はなく、発光などの光機能を有する材料 とすることで、量子ドットとの複合化に よる機能発現を目指した。最初の試みと して、亜鉛・酸素クラスターをアミノテ レフタル酸で連結した高次構造を有し、 近紫外励起で青色発光する IRMOF-3 を マトリクスとして利用し、IRMOF-3 から 赤色発光する量子ドットへとエネルギー 移動させることで、発光増強を目指した。 図7に示すように、ピリジンに配位子交 換した量子ドットに対し、IRMOF-3の原 料となる 2 物質を滴下注入したところ、 次第に溶液の発光色に変化が生じた。 MOF の形成とともに、青色の発光は強く



図6.カドミウムフリーである AgInS₂/GaS_x コア / シ ェル量子ドットも、MOF へのカプセルかによって耐 久性向上を果たしたが、MOF として ZIF-8 を用いた 場合、バンド端発光が消失した。Zn²⁺がシェルを破壊 していると考え、In³⁺の高次構造を有する InMOF を用 い、問題解決に至った。

なった一方、量子ドット由来の赤色発光はいったん強度が増加し、2 倍程度まで増加した後、著 しく低下してほとんどゼロになった。溶液の発光色はその状態を反映し、赤色発光が強くなった 後、青色へと変化した。赤色発光の増加は、当初の目論見通りに IRMOF-3 が吸収した励起エネ ルギーを、共鳴エネルギー移動によって量子ドットへと届けているからであり、量子ドット単体 では吸収できなかった範囲の光を吸収し、発光した結果である。しかし、IRMOF-3 の導入量が 増加し、量子ドットを取り囲む層の厚さが必要以上に増加すると、IRMOF-3 の励起エネルギー が量子ドットまで届かなくなり、むしろ光の遮蔽材となって赤色発光を現象させた結果である と結論付けた(*Chem. Mater.* 2021, 33, 1607)。



移動効率を実現した。

5.主な発表論文等

〔雑誌論文〕 計12件(うち査読付論文 12件/うち国際共著 0件/うちオープンアクセス 2件)

1.著者名	4.巻
Kumagai Kohei, Uematsu Taro, Torimoto Tsukasa, Kuwabata Susumu	125
2.論文標題	5 . 発行年
Variations in Photoluminescence Intensity of a Quantum Dot Assembly Investigated by Its	2021年
Adsorption on Cubic Metal-Organic Frameworks	
3. 雑誌名	6. 最初と最後の頁
The Journal of Physical Chemistry C	8285 ~ 8293
掲載論文のD01(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
10.1021/acs.jpcc.1c00232	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	-
	·
1.著者名	4.巻
Kumagai Kohei, Uematsu Taro, Torimoto Tsukasa, Kuwabata Susumu	33
2.論文標題	5 . 発行年
Photoluminescence Enhancement by Light Harvesting of Metal-Organic Frameworks Surrounding	2020年
Semiconductor Quantum Dots	
3. 雜誌名	6 . 最初と最後の百
Chemistry of Materials	1607~1617
onomietry of materials	
10 1021/acs chemmater 0c03367	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	-
1 莱考名	<u></u>
и на	116
Notomu Terruki Toshimitsu	
	5
Efficient quantum dot light-emitting diodes using 7nS/AglnS2 solid-solution quantum dots in	2020年
combination with organic characteriansport materials	20204
3 white	6 最初と最後の百
Anniad Physics Latters	
Apprila Hysics Letters	00002 00002
掲載論文のD01(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
10 1063/1 5143618	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	-
	I
1、著者名	4 .
' апа Катандат Такециа Vamanchi Hiroki Vamamoto Takahisa Mizumaki Tashiki Vukawa Hiroshi	- · E 3
Yamoto Assabiro Ikeda Shigeru Jematsu Taro Baba Yoshinobu Kuwabata Susumu Torimoto	0
Tsukasa	
2.論文標題	5 . 発行年
Tailored Photoluminescence Properties of An(In Ga)Se2 Quantum Dots for Near-Infrared In Vivo	2020年
Imaging	
3. 雑誌名	6.最初と最後の頁
ACS Applied Nano Materials	3275 ~ 3287
掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子)	 査読の有無
10.1021/acsanm.9b02608	
オープンアクセス	国際共著
オーフンアクセスではない、又はオーフンアクセスか困難	-

1.著者名 Kumagai Kohei、Uematsu Taro、Torimoto Tsukasa、Kuwabata Susumu	4.巻
2.論文標題	5.発行年
Direct surface modification of semiconductor quantum dots with metal-organic frameworks	2019年
3.雑誌名 CrystEngComm	6.最初と最後の貞 5568~5577
掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子) 10.1039/C9CE00769E	査読の有無 有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	-
1.著者名 Hoisang Watcharaporn、Uematsu Taro、Yamamoto Takahisa、Torimoto Tsukasa、Kuwabata Susumu	4.巻 9
2.論文標題 Core Nanoparticle Engineering for Narrower and More Intense Band-Edge Emission from AgInS2/GaSx Core/Shell Quantum Dots	5 . 発行年 2019年
3.雑誌名 Nanomaterials	6.最初と最後の頁 1763~1763
掲載論文のDOI(デジタルオプジェクト識別子) 10.3390/nano9121763	査読の有無 有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスとしている(また、その予定である)	
1.著者名	4 . 巻
Kameyama Tatsuya, Yamauchi Hiroki, Yamamoto Takahisa, Mizumaki Toshiki, Yukawa Hiroshi, Yamamoto Masahiro, Ikeda Shigeru, Uematsu Taro, Baba Yoshinobu, Kuwabata Susumu, Torimoto Tsukasa	3
2 . 論文標題 Tailored Photoluminescence Properties of Ag(In,Ga)Se2 Quantum Dots for Near-Infrared In Vivo Imaging	5 . 発行年 2020年
3.雑誌名 ACS Applied Nano Materials	6 . 最初と最後の頁 3275~3287
掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
10.1021/acsanm.9b02608	有
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著
1.著者名 Motomura Genichi、Ogura Kei、Kameyama Tatsuya、Torimoto Tsukasa、Uematsu Taro、Kuwabata Susumu、Tsuzuki Toshimitsu	4.巻 116
2.論文標題 Efficient quantum-dot light-emitting diodes using ZnS-AgInS2 solid-solution quantum dots in	5 . 発行年 2020年
combination with organic charge-transport materials 3.雑誌名	6.最初と最後の頁
Applied Physics Letters	093302 ~ 093302
掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
- プンアクセス	日際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	中小八百 -

1.著者名	4.巻
Hoisang Watcharaporn、Uematsu Taro、Torimoto Tsukasa、Kuwabata Susumu	⁵⁰
2.論文標題 Photoluminescence Stability Enhancement of Ag-In-Ga-S/GaSx Core/Shell Quantum Dots with Thicker Shells by the Addition of Gallium Diethyldithiocarbamate	5 . 発行年 2021年
3.雑誌名	6 . 最初と最後の頁
Chemistry Letters	1863~1866
掲載論文のDOI(デジタルオプジェクト識別子)	査読の有無
10.1246/cl.210363	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	-
1.著者名	4.巻
Hoisang Watcharaporn、Uematsu Taro、Torimoto Tsukasa、Kuwabata Susumu	₆₀
2 . 論文標題 Luminescent Quaternary Ag(InxGa1-x)S2/GaSy Core/Shell Quantum Dots Prepared Using Dithiocarbamate Compounds and Photoluminescence Recovery via Post Treatment	5 . 発行年 2021年
3 . 雑誌名	6 . 最初と最後の頁
Inorganic Chemistry	13101 ~ 13109
掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
10.1021/acs.inorgchem.1c01513	有
オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	国際共著
1.著者名	4.巻
Tepakidareekul Manunya、Uematsu Taro、Torimoto Tsukasa、Kuwabata Susumu	²⁴
2 . 論文標題 Encapsulation of AgInS2/GaSx core/shell quantum dots in In-fumarate metal-organic frameworks for stability enhancement	5 . 発行年 2022年
3 . 雑誌名	6.最初と最後の頁
CrystEngComm	3715~3723
掲載論文のDOI(デジタルオプジェクト識別子)	査読の有無
10.1039/D2CE00343K	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	
1 著者名	4
Motomura Genichi、Iwasaki Yukiko、Kameyama Tatsuya、Torimoto Tsukasa、Uematsu Taro、Kuwabata Susumu、Tsuzuki Toshimitsu	9 9 5 聚结体
2 ・研入作成型 Green Electroluminescence Generated by Band-edge Transition in Ag-In-Ga-S/GaSx Core/shell Quantum Dots	 5 . 飛行年 2021年
3.維誌名	6.最初と最後の貞
ITE Transactions on Media Technology and Applications	222~227

査読の有無

国際共著

有

-

掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子) 10.3169/mta.9.222

オープンアクセス

オープンアクセスとしている(また、その予定である)

〔学会発表〕 計22件(うち招待講演 5件/うち国際学会 7件)

1.発表者名 上松 太郎

2.発表標題 カドミウムフリー量子ドットの機能向上

3.学会等名 ニューセラミックス懇話会第241回研究会(招待講演)

4 . 発表年

2020年

1.発表者名

T. Uematsu, K. Wajima, W. Hoisang, D. K. Sharma, S. Hirata, T. Yamamoto, T. Kameyama, M. Vacha, T. Torimoto, and S. Kuwabata

2.発表標題

Narrow-Band Photoluminescence from Cadmium-Free I-III-VI Ternary Semiconductor Quantum Dots By Surface Modification

3.学会等名 PRiME 2020(国際学会)

4.発表年 2020年

1.発表者名

R. Izumi, T. Uematsu, T. Torimoto, and S. Kuwabata

2.発表標題

Fabrication and Evaluation of Electroluminescence Devices Using Quantum Dots As Light Emitting Materials

3 . 学会等名

PRiME 2020(国際学会)

4 . 発表年 2020年

1.発表者名 上松太郎,熊谷康平,鳥本司,桑畑進

2.発表標題

光捕集効果を示すMOFからのエネルギー移動による量子ドットの発光増強

3 . 学会等名

電気化学会第88回大会

4.発表年 2021年

泉 竜之介、三田 寛人、上松 太郎、鳥本 司、桑畑 進

2.発表標題

発光性半導体ナノ粒子(量子ドット)を用いたEL素子の作製:発光効率向上を目的とした素子構造の検討

3.学会等名

電気化学会第88回大会

4 . 発表年 2021年

1.発表者名

テパキッドゥアリクン マナンヤー、上松 太郎、桑畑 進

2.発表標題

Preparation of multicolor carbon dots for photoelectrochemical studies

3.学会等名

電気化学会第88回大会

4 . 発表年 2021年

1.発表者名 神畑知輝、上松太郎、鳥本 司、桑畑 進

2.発表標題

硫化ガリウムシェルを有するCu-Ag-In-S量子ドットの合成と赤色発光

3.学会等名
 2019年電気化学秋季大会

4 . 発表年

2019年

 1.発表者名 神野賢人、熊谷康平、上松太郎、鳥本 司、桑畑 進

2.発表標題

金属有機構造体(MOFs)で包埋した量子ドットの合成と発光特性

3.学会等名

2019年電気化学秋季大会

4.発表年 2019年

Taro Uematsu,Watcharaporn Hoisang,Tsukasa Torimoto,Susumu Kuwabata

2.発表標題

Photoluminescence Intensity and Quality Enhancement for AgInS2/GaSx Core/shell Quantum Dots by Improving Core Synthesis Method

3 . 学会等名

Taiwan Japan Bilateral Workshop 2019(国際学会)

4.発表年 2019年

1.発表者名

Daiki Nishimura, Taro Uematsu, Tsukasa Torimoto, and Susumu Kuwabata

2.発表標題

Synthesis of Organic Ligand Free Quantum Dots in Solid State

3 . 学会等名

Taiwan Japan Bilateral Workshop 2019(国際学会)

4.発表年 2019年

1.発表者名

笹倉卓也, 上松太郎, 鳥本司, 桑畑進

2.発表標題

Studies on exciton confinement effect of core/shell quantum dot fluorophores by photoinduced electron transfer

3 . 学会等名

電気化学会 関西支部・東海支部合同シンポジウム

4 . 発表年

2019年

1.発表者名
 上松太郎

2.発表標題

カドミウムフリー量子ドットからの バンド端発光と光学特性向上

3 . 学会等名

高分子討論会2019(招待講演)

4 . 発表年 2019年

Taro Uematsu

2.発表標題

Improvement of optical properties for cadmium-free quantum dot fluorophores

3 . 学会等名

The 65th Annual Meeting of PSJ(招待講演)(国際学会)

4.発表年 2019年

20194

1.発表者名

Kohei Kumagai, Taro Uematsu, Tsukasa Torimoto, and Susumu Kuwabata

2.発表標題

Metal-organic frameworks as novel stabilizers for semiconductor quantum dots

3 . 学会等名

The 1st Australia-Belgium-Japan joint symposium on excitonics and cellular communication(国際学会)

4.発表年 2019年

1.発表者名

Watcharaporn Hoisang, Taro Uematsu, Tsukasa Torimoto, and Susumu Kuwabata

2.発表標題

Synthesis of color-tunable Ag(InxGa1-x)S2/GaSy core/shell quantum dots

3 . 学会等名

電気化学会第87 回大会

4.発表年 2020年

1.発表者名
 西村大輝、上松太郎、鳥本 司、桑畑 進

2.発表標題

ゾル・ゲル法による量子ドット蛍光体を分散させた固体マトリクスの調製

3 . 学会等名

電気化学会第87 回大会

4 . 発表年

2020年

上松太郎,笹倉卓也,鳥本 司,桑畑 進

2.発表標題

コア / シェル量子ドットの電子構造が光励起電子移動に及ぼす影響

3.学会等名 電気化学会第87回大会

4.発表年 2020年

1.発表者名

Taro Uematsu

2.発表標題

Improving Photoluminescence Properties of Cadmium-free Quantum Dots by the Optimization of Nanostructure

3 . 学会等名

日本化学会 第100春季年会 アジア国際シンポジウム(招待講演)(国際学会)

4.発表年 2020年

1.発表者名 上松 太郎

2.発表標題 カドミウムフリー量子ドットの表面修飾と高機能化

3 . 学会等名

第18回"光"機到来!Qコロキウム(招待講演)(招待講演)

4.発表年 2021年

1 . 発表者名

上松 太郎,熊谷 康平,鳥本 司,桑畑 進

2.発表標題

キューブ状MOFを利用した量子ドット蛍光体2次元集合体の作製と粒子間エネルギー移動

3 . 学会等名

2021年電気化学会秋季大会

4 . 発表年 2021年

上松 太郎,熊谷 康平,鳥本 司,桑畑 進

2 . 発表標題

量子ドット / MOF複合体の光エネルギー移動

3.学会等名
 第67回ポーラログラフィーおよび電気分析化学討論会

4 . 発表年 2021年

1.発表者名

上松 太郎,ホイサン ワチャラポン,鳥本 司,桑畑 進

2.発表標題

結合様式の異なる配位子による多成分量子ドットの安定化と発光強度変化

3 . 学会等名

電気化学会第89回大会

4 . 発表年 2022年

〔図書〕 計1件

1.著者名	4 . 発行年
上松 太郎、桑畑 進	2020年
2.出版社	5.総ページ数
技術情報協会	16
3.書名	
次世代ディスプレイへの応用に向けた 材料、プロセス技術の開発動向	

<u>〔出願〕 計5件</u>

産業財産権の名称 量子ドット発光素子、量子ドット発光素子の製造方法、及び表示装置 	発明者 本村 玄一、都築 俊満、岩崎 有希 子、桑畑 進、上松	権利者 同左
産業財産権の種類、番号	出願年	国内・外国の別
特許、特願2021-032002	2021年	国内

産業財産権の名称 半導体ナノ粒子の製造方法及び発光デバイス	発明者 桑畑 進、上松 太 郎、鳥本 司、亀山 達矢、久保 朋也	権利者同左
産業財産権の種類、番号	出願年	国内・外国の別
特許、特願2021-036602	2021年	国内

産業財産権の名称	発明者	権利者
半導体ナノ粒子の製造方法	桑畑進、上松太	同左
	郎、鳥本 司、亀山	
	達矢、小谷松 大祐	
産業財産権の種類、番号	出願年	国内・外国の別
特許、特願2020-040094	2020年	国内

産業財産権の名称 発光材料及びその製造方法	発明者 桑畑 進、上松 太 郎、鳥本 司、亀山 達矢、小谷松 大祐	権利者 同左
産業財産権の種類、番号	出願年	国内・外国の別
特許、特願2020-040093	2020年	国内
産業財産権の名称	発明者	権利者
半導体ナノ粒子及びその製造方法	桑畑 進、上松 太 郎	同左
産業財産権の種類、番号	出願年	国内・外国の別
特許、特願2022-022901	2022年	国内

〔取得〕 計0件

〔その他〕

_

6.研究組織

(口-	氏名 マ字氏名) 容者番号)	所属研究機関・部局・職 (機関番号)	備考
(11)			

7.科研費を使用して開催した国際研究集会

〔国際研究集会〕 計0件

8.本研究に関連して実施した国際共同研究の実施状況

共同研究相手国	相手方研究機関
---------	---------